\bigcirc

Japanese Patent Laid-open Publication No.: SHO 54-109828 A

Publication date: August 28, 1979

Applicant : Asahi Kasei Corporation

Title: HEAT RESISTANT PHOTORESIST COMPOSITION

5

10

15

2. What is Claimed is:

A heat resistant photoresist composition comprising 100 parts by weight of at least one polymer selected from polyamid acids, polyamide amines, polyamid acid amines, polymercapto amide, polyhydroxyl amides, polyhydrazides, polyoxathiahydrazides, and polyimides soluble in an organic polar solvent; 0.1 to 100 parts by weight of a compound having at least two ethylene series unsaturated double bonds in a molecule; and 0.01 to 20 parts by weight of at least one photopolymerization initiating agent selected from carbonyl compounds, peroxides, azo compounds, sulfur compounds, and halides.

(9日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭54—109828

DInt. Cl.²	識別記号	50日本分類	•	庁内整理番号	43公開	昭和	口54年(19	79)8月	28日
G 03 C 1/68	•	103 B 1		6791-2H					
C 08 F 2/50		116 A 415		6358-4 J	発明の	数	1	•	
G 03 F 7/10		26(3) B 0		7267—2H	審査請	捸	未請求		
H 01 L 21/312		26(3) A 22		7377—5 F					
H 05 K 3/06	•	59 G 41		7638-5 F				(全 5	頁)
•		99(5) C 3							•

砂耐熱性フオトレジスト組成物

②特 願 昭53-16611

@出 願 昭53(1978) 2月17日

⑩発 明 者. 大村馨

富士市鮫島2番地の1 旭化成

工業株式会社内

同 柴崎一郎

富士市鮫島2番地の1 旭化成 工業株式会社内

⑫発 明 者 木村武夫

富士市鮫島2番地の1 旭化成

工業株式会社内

⑪出 願 人 旭化成工業株式会社

大阪市北区堂島浜一丁目2番6

是

明 柳

/ 発明の名称

耐熱性フォトレジスト組成物

ュ 特許請求の範囲

ポリアミド酸、ポリアミドアミン、ポリアミド 酸アミン、ポリメルカブトアミド、ポリヒドロキ シ×アミド、ポリヒドラシド、ポリオキサチアヒ ドラシド或いは有機 極性 溶鉄 可 容性 ポリイミドか ら選ばれた少なくとも 1 種以上のポリマー 1 0 0 重量部と、エチレン系不飽和二重結合を分子内に 少なくとも 2 個以上有する化合物 0.1~100重量 部と、かよびカルボニル化合物、過酸化物、アグ 化合物、イオウ化合物、ハログン化物の中から選 ばれた 1 種以上の光重合開始剤 0.01~2 0 重量部 を配合する事を特徴とする耐熱性フォトレジスト 組成物

2 発明の詳細な説明

本発明は、絶談性および射熱性に優れた新規な フォトレジスト組成物に関するものである。

今までに各種のフォトレジストが開発されてい

るが、これちの多くは感光性というだけであり、 感光性と絶縁性および耐熱性などの特性を合わせ 持つたものはない。

近年、電子産業分野では、半導体回路、ハイブリット回路などでかいては、高密度化の要請により、多層化の方向に進んでいる。しかしながら、従来のフォトレジストでは、 絶縁性および耐熱性などの特性が悪く、上配回路に残存させることは不可能であり、絶縁性および耐熱性が優れた、上配回路に残存させることの可能なフォトレジストが設まれている。

本発明者らは、上記特性を持つたフォトレジストを開発すべく鋭意研究した結果、有機極性溶媒可溶性の耐熱性ポリマーに、エチレン系不飽和二 直結合を分子内に少なくとも 2 個以上有する化合物を、上記ポリマーに対して 0.1~100 5 配合する事により、はじめて與用特性を有する耐熱性フォトレジストが得られる事を見出し、本発明を完成するに到つた。

即ち、本発明は、ポリアミド酸、ポリアミドア

– 2 –

禁留 昭54-109828(2)

ミン、ポリアミド酸アミン、ポリノルカブト、ポリモドロキンプミド、ポリヒドラジドは有機低性溶性、可性ポリイミドから選ばれた少なくとも1種以上箱台を分子内に少なくとも2個以上有する化合合物、の1~100重量部と、およびカルボニル化合合物、の酸化物、アン化合物、イオウ化合物、ハロ合物、ン化物の中から選ばれた1種以上の光重合別が分配の中から選ばれた1種以上の光重合別が対し、0.01~20重量部を配合する事を特徴とするものである。性フォトレジスト組成物を提供するものである。

本発明の如く、ポリアミド酸、ポリアミドアミン、ポリアミド酸アミン、ポリメルカプトアミド、ポリヒドラジド、ポリオキサチアヒドラジド或いは有機極性科群可溶性が関イミドから選ばれた少なくとも1種以上の有機を性がリマーに、エチレン系を性が明溶性の耐熱性ポリマーに、エチレン系を抱和二度結合を分子内に少なくとも2個以上有する化合物を、上記ポリマーに対して0.1~100

一般式

(ことで R. は芳香 取を 有する 4 側の 基であり、 R. は芳香 取を 有する 2 個の 基で ある) で 袋 わされる 様々 芳香 族 ポリアミド酸、 芳香 族 ジアミノアミドと 芳香 族 ジアミン および 芳香 族 テトラカルポン酸 二 無水 物 から 合成 される 一般式

(ことで R は芳香 理を有する 3 価の基であり、 R は芳香 現を有する 4 価の基であり、 R は芳香 現を有する 2 価の基である) で表わされる 様な 芳香族 ポリアミト酸、芳香族テトラワミンと芳香族 ジカルボン酸エステルなどから合成される一般式

(ことで:.R.o.は芳香馥を有する2価の基であり、 R.o.は芳香取を有する4価の基である)で表わされる様な芳香族ポリアミドアミン、芳香族テトラア 性、絶録性などの優れた特性を有するフォトレジストが可能であり、エチレン系不飽和二重結合を分子内に少なくとも2個以上有する化合物を、上記ポリマーに対して100重費 多以上配合した場合は耐熱性が劣り、0.1 重量多以下配合した場合は感光性が劣る結果となる。

本発明に用いられるポリアミド酸、ポリアミド アミン、ポリアミド酸アミン、ポリメルカプトアミド、ポリヒドロキシアミド、ポリヒドラシド、ポリセドラシド ポリオキサチアヒドラジド或いは有機極性密媒可 溶性ポリイミドとしては、特に芳香族のものが好 ましく、例えば芳香族ジアミンと芳香族無水トリ カルボン酸ハライドなどから合成される一般式

(ここで R.は芳香環を有する 3 価の基であり、 R. は芳香環を有する 2 価の基である) で扱わされる 様な芳香族ポリアミド酸、芳香族ジアミンと芳香族テトラカルポン酸二無水物などから合成される

ミンと芳香族テトラカルポン酸二無水物などから 合成される一般式

(ここで Rio は 芳香 取を有する 4 価の 基で あり、 Rio は 芳 香 取を有する 4 価の 基で ある) で 表わさ れる 様な 芳香 族 ポリアミド酸 アミン、 芳香 族 ジメ ルカプトジアミン の 塩酸 塩と 芳香 族 ジ酸 ハライド などか 5 合成 される 一般式

$$+$$
 HN $-$ RII $-$ NH $-$ OC $-$ RII CO $+$.

HS SH

(ここで Ru は芳香取を有する 4 価の基であり、 Ru・は芳香取を有する 2 価の基である) で表わされる芳香族ポリメルカブトアミド、芳香族ジヒドロキンジアミンと芳香族ジ酸ハライドなどから向成される一般式

(ととて R.u. は芳香理を有する 4 価の基であり、 R.i. は芳香理を有する 2 価の基である)で扱わ

_

特別 四54-109828 (3)

される芳香族ポリヒドロキシアミド、芳香族シ酸 ヒドラシドと芳香族シ酸ハライドなどから合成さ れる一般式

+HN-HN-OC-Ri-CONII-NII-OC-Ri-CO+.

+NH-HN-SC-R₁₁-CS-NH-NH-OC-R₁₁-CO→

(とこて R₁₁ 及び R₁₂ は 芳香 琅を 有する 2 価の基で

ある)で表わされる芳香族ポリカキサチアヒドラジド、アメカンケミカルソサイアテイ、ポリマーブレブリント 1 7 巻 2 号 3 5 3 ~ 3 5 8 頁 (1976年) および特公昭 5 2 - 3 0 3 1 9 号 などに記載されている芳香族ジアミンと芳香族テトラカルポン酸から合成される一般式

$$\left\{ \begin{array}{c} CO \\ CO \end{array} \right\} R \left\{ \begin{array}{c} CO \\ CO \end{array} \right\} N - R \left\{ \begin{array}{c} A \\ A \end{array} \right\}$$

(ととで R. は芳香 現を有する 4 価の基であり、 R. は芳香 現を有する 2 価の基である) で表わさ

- 7 -

テトラエチルチウラムシスルフイドなどのイオウ化合物、四塩化炭染などのハロゲン化物などがあり、これらは単独或いは混合して用いても良い。これらの光重合開始剤の添加量は、上記ポリマーに対して0.01~20重量多時に0.1~10重量多が好ましい範囲である。

本組成物は、実質的に容解するN・Nージメチルアセトアミド、N・Nージメチルホルムアミド、N・Nージメチルホルムアミド、Nーメチルピロリドン、ジメチルスルホキンド、ヘキサメチルホスホアミド、クレゾールなどの有機値性容解を用い、容液の粘度は所望の破膜の厚さに合わせて調節することができ、この容液は噴霧または浸漬法或いはローラーなどにより強布される。

本発明の画像形成プロセスの1例を次に示す。本発明にかかる組成物を基板上に強布し、実質的に粘性のない状態に乾燥して、例えば水銀ランプなどの紫外級で所定のパターンに爆光される。爆光時間は適宜選定されるが、長い解光時間は一般的に有害ではない。紫外線などによる似光後、前

れる様な有機極性溶媒可溶性芳香族ポリイミトなどがある。

本発明に使用されるエチレン系不飽和二重結合を分子内に 2 個以上有する化合物 としては、ブチレンクリコールジ(メタ)アクリレート、ボリンクリコールジ(メタ)アクリレート、ボリントリ (メタ) アクリレールプロペントリ (メタ) アクリレール ステトラメチロールメタンテトラ (メタ) アクリルアミド、ヘキサメチレンピス(メタ) アクリルアミド ながある。 これらの 低音物は 上記 ポリマーの 範囲で好ましく使用される。

本発明に使用される光重合開始剤としては、アセトフェノン、ジアセチル、ベンソフェノン、ベンソイン、ベンソイン・ロロアントラキノン、ナフトキノンなどのカルポニル化合物、過酸化ペンソイルなどの過酸化物、アソビスインプチロニトリルなどのアソ化合物、

— 8 —

記録布容媒 求いは前記録布容媒と非溶媒との混合 容媒 または アルカリ 水溶液 などの 適当な 溶剤 を用いて非 郷光部を洗出す。 また必要に応じて、洗出し後 加熱処理が施され、 特にポリマーとしてポリアミド酸、 ポリアミドアミン、 ポリメルカプド、 ポリヒドロキンアミド、 ポリヒドラジド 就いは ポリアミド 酸 取り ない は ポリア ま ア 酸 は いは イミダゾール 瑕を形成せしめる。

以下に本発明の態様を一層明確にするために、 実施例を挙げて説明するが、本発明は実施例によ りその範囲を制限されるものではない。

実施例1

メタフエニレン ジアミン 3.1 ををジメチルホルムアミド 8 0 をに溶解したものに、ピロメリト酸二無水物 5.5 を を徐々に添加して、その後望紫雰囲気下室温で攪拌してポリアミド酸溶液を 得た。 この様にして得られたポリアミド酸溶液を で、テトラメチロールメタンテトラアクリレート 0.9 を およびペングインインプロビルエーテル 0.3 を を添

特開 昭54-109828(4)

作成した。このフォトレジスト組成物を、実施例 i と同様に処理して解光した。次いでN-メチル - 2 - ピロリドンとメタノール(3 : 2 容量比) の混合溶媒で、非解光部を洗出して現像した後、 300℃で 1時間加熱処理して、ネガ型の凹凸パタ ーンを得た。その後の熱天秤による耐熱性テスト では、窒素気流下10℃/分の昇温速度で重量波 少を測定しよところ、400℃まで顕著な重量減少 は認められなかつた。

出顧人 旭化成工菜株式会社

- 12 -

加して、フォトレジスト組成物を作成した。との フォトレジスト組成物を、ガラス基板上に乾燥後 5 p 厚になる様に強布して、 3 Kw 水銀ランプを 用いて所定のパターンマスクを通して10分間路 光した。次いで pH8~9 の水稻液で非解光部を洗 出して現像した後、250℃で1時間加熱処理して、 オガ型の凹凸パターンを得た。その後の熟天秤に よる耐熱性テストでは、窒素気流下10℃/分の 昇温速度で重量減少を測定したととろ、350でま で顕著な重量減少は認められなかつた。

奥施例 2

. .

4,4'ージ(mーアミノフエノキシ)ジフェニ ルエーテル 3.8 9 と 3、3′、4、4′ーペ ンゾフェ ノンテトラカルポン酸二無水物 3.2 タ とN-メチ ルー2ーピロリドン609 およびトルエン109 を混合指押し、窒素ガスを通じながら140℃で 6 時間反応させてポリイミド溶液を得た。このよう にして待られたポリイミド溶液に、N,N'ーメチ レンピスアクリルアミド 1.4 まおよび アセトフェ ノン 0.3 9 を添加して、フォトレジスト組成物を

-- 11 --

手 続 補 正 群(自弘)

明初55年6月29日

特許庁長官 館 谷 兽 二 殿

- 1. 事件の表示 昭和 53年特許随第
- 2 発明の名称

耐熱性フォトレジスト組成物

3 補正をする者

事件との関係 特許出願人 大阪府大阪市北区堂島兵1丁目2番6号 (003) 旭化成工案株式会社

取締役社長



4. 補正の対象

明湖省の「特許請求の紅斑」及び「発明の辞」 細な説明しの機



- 5. 補正の内容
- (1) 明細省の特許請求の範囲を別紙の通り補正す
- (2) 同年1頁下から2行目「R₁₂」を「R₂₀」と 補正する。
- (3) 同類 7 頁末行「R₁₅」を「R₂₁」と補正する。
- 抑入する。「これらのポリマーのうちで、特化 芳香族ポリアミド酸および有機極性溶媒可溶性 芳香族ポリイミドが好適であり、更に有機極性 溶媒可容性芳香族ポリイミドがより好ましい。」
- (5) 同第10頁第8.~9行「イミド環或いはイミ ダザール選」を「イミド環、イミダザール環、 チアゾール環、オキサゾール環、オキサジアゾ ール琪或いはチアジアゾール琪」と補正する。

以上

特許請求の範囲